

## [S-01]

# Low energy ion beam을 이용한 폴리이미드 표면개질 및 Cu-폴리이미드 접착력 증대

박종용<sup>1)2)</sup>, 변동진<sup>2)</sup>, 최원국<sup>1)</sup>

한국과학기술연구원 박막재료연구센터<sup>1)</sup>, 고려대학교 재료공학<sup>2)</sup>

Stationary plasma thruster source를 이용하여 flexible copper clad laminate (FCCL)-용 폴리이미드 표면을 개질하고, Cu와의 접착력변화와 폴리이미드의 표면변화를 XPS를 통하여 조사하였다. 160-210 eV의 매우 낮은 이온빔 에너지를 사용하였으며, 이온선량을  $5 \times 10^{15}/\text{cm}^2$ 부터  $10 \times 10^{18}/\text{cm}^2$  변화시켰으며, 이온전류 밀도 의존성을 알아보기 위하여 이온 밀도는 0.5-0.9 mA/cm<sup>2</sup> 까지 변화시켰다. 0.5mA/cm<sup>2</sup>에서 표면 처리시 Ar<sup>+</sup>의 경우 80°에서 35°까지, N<sub>2</sub><sup>+</sup>, O<sub>2</sub><sup>+</sup>, N<sub>2</sub>O<sup>+</sup>의 경우  $5 \times 10^{17}/\text{cm}^2$ ,  $1 \times 10^{17}/\text{cm}^2$ ,  $5 \times 10^{16}/\text{cm}^2$ 의 이온선량에서 차례로 D·I water의 경우 80°에서 0°에 가까운 각도까지 변화 되었으며 Ethylene glycol의 경우는 또한 40°에서 0°에 가까운 각도까지 변화되었다. 한편 0.8 mA/cm<sup>2</sup>로 이온 전류 밀도를 높였을 경우, O<sub>2</sub><sup>+</sup> 이온을 사용했을 때  $1 \times 10^{16}/\text{cm}^2$ 에서 4° 정도의 낮은 접촉각을 보이는 우수한 결과를 얻었다. Ar<sup>+</sup>+O<sub>2</sub><sup>+</sup>, Ar<sup>+</sup>+N<sub>2</sub>O<sup>+</sup> 혼합 이온을 주입한 경우 O<sub>2</sub><sup>+</sup>의 경우보다 더 낮은 이온 선량에서 낮은 접촉각을 보이는 우수한 결과가 나타났다. 이때 표면에너지는 38.1 mN/m에서 81.1 mN/m까지 증가되었다. O<sub>2</sub><sup>+</sup>로 처리한 PI 위에 전기 도금된 Cu(12μm) 층의 경우 peel strength는 0.76 kgf/cm로 높게 측정되었다.

XPS 분석을 통한 폴리이미드 표면의 C, N, O 농도 변화를 측정한 결과 Ar<sup>+</sup> 이온을 주입했을 경우를 제외한 나머지 이온에서는 C의 함량이 감소하다가 다시 증가하는 결과를 나타내었다. C1s, O1s, N1s XPS spectrum의 분석을 통하여 C-C-C, C-N-C, C-O-C, C=O chemical bonding 양의 변화에 따른 peel strength의 증가를 조사하였다.